



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры п-р-п высокочастотный малой мощности. Предназначен для применения в гибридных схемах с общей герметизацией и в негерметичных объемах с дополнительным покрытием лаком или компаундом. Выпускается в миниатюрном пластмассовом корпусе, тип корпуса КТ-46. Масса транзистора не более 0,015 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ

при $U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_b = 2 \text{ мА}$:

$T = +25^\circ\text{C}$	100...300
$T = 85^\circ\text{C}$	80...360
$T = -45^\circ\text{C}$	30...300

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте

при $U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_k = 30 \text{ мА}$, $f = 100 \text{ МГц}$, не менее

Граничное напряжение при $I_k = 10 \text{ мА}$, $I_b = 0$, не менее

Время рассасывания при $I_k = 10 \text{ мА}$, $I_b = 1 \text{ мА}$, $t_n \leq 30 \text{ мкс}$, $Q > 50$, не более

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_k = 150 \text{ мА}$, $I_b = 15 \text{ мА}$, не более

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_k = 10 \text{ мА}$, $I_b = 1 \text{ мА}$, не более

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 \text{ В}$, $f = 10 \text{ МГц}$, не более

Емкость эмиттерного перехода при $U_{об} = 0$, $f = 10 \text{ МГц}$, не более

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = -45 \text{ В}$, не более:

$T = +25^\circ\text{C}$	0,05 мкА
$T = +85^\circ\text{C}$	50 мкА
$T = -45^\circ\text{C}$	0,05 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{об} = 1 \text{ кОм}$

Постоянное напряжение эмиттер-база

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при $t_n < 10 \text{ мкс}$, $Q > 2$

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T = -45...+25^\circ\text{C}$

Температура р-п перехода

Температура окружающей среды

¹При $T = +25...+125^\circ\text{C}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора

определяется из выражения

$$P_{к\text{ макс}} = (150 - T) / 417, \text{ Вт}$$

